
	<h2>SI8429DB-T1-E1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI8429DB-T1-E1</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 8V 11.7A 2X2 4-MFP</p> <p>Datenblätter:  SI8429DB-T1-E1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 27998 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI8429DB-T1-E1
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 8V 11.7A 2X2 4-MFP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	27998 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 8V 11.7A (Tc) 2.77W (Ta), 6.25W (Tc)
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	4-XFBGA, CSPBGA
Supplier Device-Gehäuse	4-Microfoot
Verlustleistung (max)	2.77W (Ta), 6.25W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11.7A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	35 mOhm @ 1A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	800mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1640pF @ 4V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.2V, 4.5V
Vgs (Max)	±5V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI8429DB-T1-E1TR

SI8429DB-T1-E1 ist neu im Original, Suche SI8429DB-T1-E1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI8429DB-T1-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI8429DB-T1-E1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI8424DB-T1-E1 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 8V 12.2A 2X2 4-MFP</p>	 <p>SI8424DB-T1-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 8V 12.2A 2X2 4-MFP</p>	 <p>SI8430-B-IS Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC</p>	 <p>SI8430-BIS SILICON SI8430-BIS SILICON</p>
 <p>SI8429DB-T1-E1 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 8V 11.7A 2X2 4-MFP</p>	 <p>SI8425DB-T1-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V MICROFOOT</p>	 <p>SI8430-B Silicon SI8430-B Silicon</p>	 <p>SI8425DB-T1-E1 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V MICROFOOT</p>

heiße Teile

Mehr

SI8405DB-T1-E1	SI8405DB-T1-E3	SI8405DB-T1-E3	SI8409DB-T1	SI8409DB-T1-E1
SI8409DB-T1-E1	SI8410AB	SI8410BB-D-ISR	SI8410BB-I-DS	SI8413DB-T1-E1
SI8413DB-T1-E1	SI8415DB-T1	SI8415DB-T1-E1	SI8415DB-T1-E1	SI8417DB-T2-E1
SI8417DB-T2-E1	SI8420BB	SI8420BB-D-IS	SI8421AB-D-ISR	SI8422AB-D-ISR
SI8422BD	SI8424DB-T1-E1	SI8424DB-T1-E1	SI8425DB-T1-E1	SI8425DB-T1-E1
SI8429DB-T1-E1	SI8430-A-IS	SI8430-BIS	SI8430-C-IS	SI8430AB-D-IS
SI8430AB-D-ISR	SI8430BB-C-IS	SI8430BB-D-IS	SI8431-A-IS	SI8431-BIS
SI8431-C-IS	SI8431AB-C-IS	SI8431AB-D-IS	SI8431AB-D-IS1R	SI8431BB-C-IS
SI8431BB-D-IS	SI8435-B-IS	SI8435-B-ISR	SI8435BB-D-IS	SI8440-A-IS
SI8440-BIS	SI8440-C-IS	SI8440-C-ISR	SI8440AA	SI8440AA-D-IS

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

